خواص ساختاری، الکترونی و ارتعاشی ترکیب BaHfO₃ در فاز مکعبی

بر پایه ی محاسبات اصول اولیه

حیدرعلی شفیعی گل^{۰۱}* و مرتضی فاضل زاده^۲ ^{روه}گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

تاریخ دریافت: ۹۴/۰۳/۱۹ تاریخ تصحیح:۹۴/۰۹/۲۲ تاریخ پذیرش: ۹۴/۰۹/۲۶

چکیدہ

واژ گان كليدى : خواص الكترونى ،مد ارتعاشى ، قطبش پذيرى ، دى الكتريك، باريم هافنيمات ، بار موثر

۱- مقدمه

ABX_۳ ماده ای با ساختار بلوری پروسکایت است که در آن A یک کاتیون یک یا دو ظرفیتی، B یک عنصر واسطه چهار ظرفیتی و X هم آنیونی نظیر اکسیژن ، نیتروژن و فلوئور می باشد[۳–۱] و خواصی مانند فروالکتریکی[۵–۴] ، فعالیت های کاتالیزوری [۶] و ترموالکتریکی [۷] را به همراه دارد. این خواص می توانند در کاربرد های فن آوری از قبیل لیزر، حسگرهای اکسیژن دمای بالا ، حافظه های غیر فرار ، مواد محرک پیزوالکتریک و خازن با ظرفیت بالا مورد استفاده قرار گیرند[۱۰–۸]. باریم هافنیمات (۳) از پروسکایت های اکسیدی نوع ۲۸۹۰ است که به عنوان ماده ای با درجه حرارت بالا(۲۸۹۳K) شناخته شده[۱۱]

^{*.} نویسنده مسئوول: استادیار فیزیک ماده چگال، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان shafiei@phys.usb.ac.ir

و به علت عدد اتمی موثر و چگالی بالا(۶۴/۵۸ و ۲۰۰ ۸/۵ می تواند با ضریب شکست بالاتری (نسبت به سایر مواد کاربردی) در محدوده ی اشعه -X پزشکی جهت تصویربرداری مسطح و سی تی اسکن مورد استفاده قرارگیرد [۱۳–۱۲]. در این مقاله سعی شده است که آلیاژ BaHfOr از لحاظ ساختاری، الکترونی و ارتعاشی مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور، روش محاسباتی در بخش بعدی و نتایج حاصل از محاسبات در بخش سوم ارائه می گردند و نهایتا، بخش چهارم کار انجام شده را جمع بندی می کند.

۲- روش محاسبات

محاسبات بر پایه تقریب بورن – اوپنهایمر و نظریه تابعی چگالی هوهنبرگ–کوهن [۱۴] بوده و معادلات تکذره ای برای ساختار الکترونی در روش شبه پتانسیل با فرمولبندی کوهن-شم [۱۵] و به روش خودسازگار در بسته نرم افزاری کوانتم اسپرسو[۱۶] حل میشوند. توابع ویژه الکترونی مربوط به معادلات کوهن-شم با انرژی جنبشی قطع ۹۰.۲پر حسب امواج تخت بسط داده شده و دقت مطلوب ۷^{-۱۰} برای اجرای محاسبات انرژی الکترونی، و Å/^۳ ۱۰۰ برای هر مولفهی نیروی وارد بر هر اتم در نظر گرفته میشود. همچنین تقریب های چگالی موضعی (LDA) در فرم سپرلی–آلدر (CA)[۱۷] و شیب تعمیم یافته (GGA)

۳- نتایج و بحث محاسبات

۳-۱- ساختار بلوری

در ساختار مکعبی BaHfO_۳ ، اتمهای باریم در گوشههای یاخته (مکعب) قراردادی، اتم هافنیم در مرکز و اتمهای اکسیژن نیز در مرکز سطوح مکعب قرار دارند که طرحواره ای از آن در شکل ۱ نشان دادهشده است. این ساختار متعلق به گروه فضایی Pm۳m



شكل ۱: سلول واحد براى ساختار مكعبى "BaHfO.

اولین گام برای مطالعه نظری خواص فیزیکی یک بلور، بهینه سازی پارامترهایی نظیر ثابت های شبکه، انرژی قطع، تعداد نقاط عددموج و انرژی بر حسب حجم می باشد. برای این منظور، محاسبات فوق با دو تقریب LDA و GGA برای فاز مکعبی باریم هافنیمات انجام شده که نتایج آن در جدول ۱ طبقه بندی گردیده و بطور نمونه نیز، منحنی تغییرات انرژی بر حسب ثابت شبکه (در تقریبGGA) در شکل ۲رسم شده است.

تئورى	a (a.u.)	V(a.u.) ^r	E (Ry)	B (GPa) [14]
GGA	٨/•١۵	۵۱۴/۸۸۵	-240/9.52	
LDA	٨/١٧٠	545/222	$-191/\lambda\Delta$ W	۱۸۶
تجربی [۱۵]	Υ/λλ	ዮ አ۹/۳ ۰ ۳አ		

جدول ۱: مقادیر ثابتهای تعادلی ، مدول حجمی، حجم بهینه و انرژی کل شبکه مکعبی BaHfO.

همانطور که در جدول ۱ مشاهده می شود ثابت شبکه در تقریب GGA به مقدار تجربی نزدیکتر بوده و در مقایسه با LDA برای فاز مکعبی دارای مقدار کوچکتری است که می توان این اختلاف را به تفاوت در انرژی تبادلی-همبستگی دو تقریب GGA و LDA نسبت داد. تعداد h-point بهینه شده برای ساختار ۳۵HfO با پارامترهای بهینه شده فوق الذکر دارای ابعاد ۴×۴×۴ (با جابجایی ۱×۱×۱) در منطقه اول بریلوئن می باشد که در محاسبات بعدی نیز بکار می روند.



شکل ۲: نمودار تغییرات انرژی برحسب حجم برای ساختار مکعبی BaHfOr به روش GGA.

٣-٢- خواص الكتروني

۳-۲-۱- ساختار نواری

ساختار نوارهای انرژی بیانگر بازه ی انرژی برای نوار های مجاز و غیر مجاز (گاف انرژی) است که این ساختار در شکل های ۳ و ۴ برای فاز مکعبی BaHfO₇ و در امتداد نقاط تقارنی اصلی در گستره ۱۰eV– تا ۱۵eV برای تقریب LDA و گستره انرژی ⁽¹eV– ا تا ۱۰eV برای تقریب GGA نشان داده شده اند. در این نمودارها، مقیاس انرژی صفر نشان دهنده مکان انرژی فرمی بوده که با خط افقی نشان داده شده است. همانطور که در شکل ها دیده می شود: ۱- تقاطع نوارهای انرژی در راستای بعضی از محورهای تقارنی بلور از جمله M→X و D→M (که G مرکز شبکه بریلوئن، ۱۰eV، می باشد) در مقایسه با سایر محورها بیشتر است که به تقارن توابع موج در آن محدوده ارتباط دارد. ۲- میزان پهن شدگی نوارهای واقع در زیر تراز فرمی (حدود VeC) در مقایسه با نوارهای بالای آن (حدود Va Cy) کمتر است. ۳– تبهگنی نوارهای انرژی در زیر تراز فرمی (حدود VeC) در مقایسه با ایالای تراز فرمی به G اختصاص دارند. ۴ – در این شکل ها، یک گاف مستقیم (در نقطه G مرکز شبکه وارون) دیده می شود که اندازه ی آن برابر Va Va Va Va کر Da کر است. ۳– تبهگنی نوارهای انرژی در زیر تراز فرمی بیشتر به نقاط X و G و برای نوارهای اوارهای بالای آن (حدود Va Cy) کمتر است. ۳– تبهگنی نوارهای انرژی در زیر تراز فرمی بیشتر به نقاط X و G و برای نوارهای اورساین که بالای تراز فرمی به G اختصاص دارند. ۴ – در این شکل ها، یک گاف مستقیم (در نقطه G مرکز شبکه وارون) دیده می شود که اندازه ی آن برابر Va Va Va که یاری تقریب AGA و Va Ma کها، یک گاف مستقیم (در نقطه G مرکز شبکه وارون) دیده می شود که اندازه ی آن برابر Va Va ترای قرمی همتند از اوربیتالهای LDA و Va Ma که نشآت گرفته در حالی که بیشترین سهم نوار ظرفیت مربوط به رسانش که بالای تراز فرمی همی نوار خای قریب AGA می باشد. ۵– پایین ترین نوارها در ناحیه



شکل۳: ساختار نواری BaHfOr در فاز مکعبی با تقریب LDA.



شکل۴: ساختار نواری،BaHfO در فاز مکعبی با تقریب GGA.

۳-۲-۲- چگالی حالت ها

از عوامل اساسی در تعیین خواص الکترونی جامدات، توزیع انرژی الکترونهای نوار رسانش و ظرفیت است که می توان نتایج حاصل از اجرای محاسبات را به صورت منحنی چگالی حالت بر حسب انرژی ارائه کرد. سطح زیر منحنی چگالی حالت بر حسب انرژی، بیانگر تعداد حالت های مجاز برای حضور الکترون ها در آن بازه انرژی می باشد. این کمیت در تحلیل توابع دیالکتریک، خواص ترابری و طیف نور گسیل جامدات نقش مهمی ایفا می کند. همچنین مقادیر نظری همچون انرژی الکترونی جامد، موقعیت سطوح فرمی و احتمال تونل زنی الکترونها به محاسبات دقیق چگالی حالتهای الکترونی نیازمند- اند[۲۰]. شکل ۵ چگالی، حالتهای فاز مکعبی ۳۵هال تونل زنی الکترونها به محاسبات دقیق چگالی حالتهای الکترونی نیازمند- اند[۲۰]. شکل ۵ چگالی، حالتهای فاز مکعبی ۳۵هال تونل زنی الکترونها به محاسبات دقیق چگالی حالتهای الکترونی نیازمند- اند[۲۰]. شکل ۵ چگالی، حالتهای فاز مکعبی ۳۵هال تونل زنی الکترونها به محاسبات دقیق چگالی حالتهای الکترونی نیازمند- اند[۲۰]. شکل ۵ چگالی، حالتهای فاز مکعبی ۳۵هال تونل زنی الکترونها به محاسبات دقیق چگالی حالتهای الکترونی نیازمند- اند[۲۰]. شکل ۵ چگالی، مالتهای فاز مکین محود نشان داده شده است. همانطور که در نمودارها دیده می شود، بیشترین سهم اتمهای باریم در قسمت پایین طیف، اتمهای اکسیژن در بالای نوار ظرفیت و اتمهای هافتیم در پایین نوار رسانش است.



شکل۵: چگالی حالتهای کلی برای ساختار مکعبی،BaHfO به روش : الف. LDA و ب. GGA .

۳-۲-۳- چگالی بار الکترونی

توزیع چگالی بار از ویژگیهای مهم جامدات است که می تواند توصیف خوبی از خواص شیمیایی یک ترکیب را ارائه دهد. بررسی گرایشهای شیمیایی یک ماده بهعنوان بخش بسیار مفیدی در مطالعه خواص حالتجامد به شمار می آید[۲۰]. در چگالی بار الکترونی کل ۳BaHfO که در شکل ۶ نشان دادهشده ، توزیع بار اطراف اتمهای باریم ، هافنیم و اکسیژن گویای این موضوع است که پیوند بین اتم های Ba و O خصلت یونی و بین اتمهای Hf و O خصلت یونی-کووالانسی دارند که این رفتار با توجه به اختلاف الکترونگاتیوی اتم های (۹۹۰)-Ba(د (۹۹۰) و (۳/۴۰)-(۱/۳۰) نیز قابل انتظار است.



شکل ۶: چگالی بار الکترونی دو بعدی BaHfO، در فاز مکعبی بین اتم های الف) Hf و O ب) بین Ba و O.

۳-۳- خواص ارتعاشی

۳–۳–۱– مد های فونونی

مد های فونونی به دو دسته ی مد های اکوستیکی ((طولی (LA) و عرضی (TA)) و اپتیکی ((طولی (LO) و عرضی (TO)) تقسیم بندی می شوند که چنانچه P اتم در یاخته بسیط ترکیب وجود داشته باشد، رابطه پاشندگی آن دارای ۳۲ شاخه خواهد بود که سه تای آنها آکوستیکی و ۳-۳۳ تای دیگر اپتیکی هستند. نمودار پاشندگی فونونی، وابستگی فرکانس های فونون ها به بردار موج را در راستای مختلف نشان می دهدکه به صورت

$$\omega^{\mathsf{r}} = \frac{\mathsf{r}}{M} \sum C_p \left(\mathsf{1} - cospka \right)$$

بیان می شود و در آن شیب ۵ بر حسب k در مرز منطقه بریلوئن صفر است و برای امواج کشسانی که در گستره ای از k و در منطقه اول بریلوئن واقع باشند دارای معنای فیزیکی است [۲۱]. همچنین مد های طبیعی ارتعاش ، ۵، و الگویی جابجایی فونون ، ۱۹، به وسیله فرمول زیر تعیین می شوند:

$$\sum_{s'\beta} D_{s\alpha s'\beta}(q) u_{s'\beta}(q) = \omega_q^{\mathsf{T}} u_{s\alpha}(q)$$

که

$$D_{s\alpha s'\beta}(q) = \frac{1}{\sqrt{M_s M_{s'}}} \sum_{\nu} \frac{\partial^{\mathsf{T}} E}{u_{\mu s\alpha} u_{\nu s'\beta}} e^{iq(R_{\nu} - R_{\mu})}$$

که ^{δ¹E}/_{µµsα^uvs/β} ثابت های نیروی داخلی را بیان می کند. بطور کلی می توان این فرمول را برای محاسبه ماتریس دینامیکی بلور بکار برد[۲۱]. نتایج حاصل از محاسبات GGA نشان می دهد که از ۱۵ مد فونونی بدست آمده برای ۳GGA ، ۳ مد آن آکوستیکی و ۱۲ مد دیگر اپتیکی اند[۲۱] که در جدول ۲ ارائه شده اند. همانطور که مشاهده می شود مدهای اکوستیکی دارای فرکانس های پایین و مدهای اپتیکی دارای فرکانس های بالاتری هستند.

شماره مد	نوع مد	فرکانس مد(cm⁻۱) فرکانس
١	آكوستيكى	ft/0fxt
٢	آكوستيكى	ft/0fxt
٣	آكوستيكى	£4/9£74
۴	اپتیکی	<i>۱۰۶/۶</i> ۸۹۰
۵	اپتیکی	<i>\ • ۶/۶</i> ८٩ •
۶	اپتیکی	<i>۱۰۶/۶</i> ۸۹۰
۷	اپتیکی	3449/2922
٨	اپتیکی	344/0922
٩	اپتیکی	3449/2922
١٠	اپتیکی	411/1048
11	اپتیکی	411/1048
١٢	اپتیکی	411/1848
١٣	اپتیکی	۵۲۹/۲۶۲۵
14	اپتیکی	۵۲۹/۲۶۲۵
16	اپتیکی	۵۲۹/۲۶۲۵

جدول ۲: مقادیر فرکانسی مدهای ارتعاشی (اپتیکی و آکوستیکی) BaHfOr در حالت مکعبی بر پایه GGA .

شکل ۷ پنج گروه نقطه ای بلور نگاری مکعبی و جدول ۳ نیز خلاصه مدهای ارتعاشی را برای باریم هافنیمات نشان می دهند.



شکل ۲: اشیای دارای تقارن پنج گروه نقطه ای بلور نگاری مکعبی[۲۲].

جدول۳: خلاصه مدهای ارتعاشی (اپتیکی و آکوستیکی) باریم هافنیمات (در تقریبGGA) با گروه نقطه ای O_h.

شماره	ω (cm ⁻¹)		مد	
(1-٣)	۴۳/۵	$T_{\lambda u}$	$\mathrm{G}_{\scriptscriptstyle \lambda \Delta}$	Gŗ
(۴-۶)	۱・۶ /۸	$T_{\gamma u}$	${ m G}_{{\scriptscriptstyle 1}{\scriptscriptstyle \Delta}}$	Gŗ
(۲–۹)	۳۴۹/۵	T_{ru}	$G_{{\tt Y}{\tt D}}$	$\mathrm{G}_{\scriptscriptstyle{\Delta}}$
(117)	۴۱۱/۱	$T_{\lambda u}$	$\mathrm{G}_{\scriptscriptstyle 1\Delta}$	Gŗ
(17-10)	589/5	$T_{\lambda u}$	${ m G}_{{}_{1 \Delta}}$	$\mathrm{G}_{\mathfrak{k}}$
-				

۳-۳-۲- چگالی مد ها و نمودار پاشندگی

تعداد مد های موجود در واحد گستره بسامد را چگالی مد ها ،(g(a)، می گویند که از رابطه زیر بدست می آید[۴]:



شکل۸: چگالی حالت های فونونی برای BaHfO،در فاز مکعبی با تقریب GGA .

در شکل ۸ که چگالی حالت های فونونی را نشان می دهد دو پیک یکی در فرکانس های پایین ^{۱-}۴۳cm و دیگری در فرکانس های پایین (۴۳cm و دیگری در فرکانس های پایین (۴۱۰cm و دیگری در بازه ی های بالا^{۱-}۴۱۱cm) وجود دارند که معرف مدهای اکوستیکی و اپتیکی ترکیب می باشند. همچنین دو گاف فرکانسی در بازه ی (۱۲۰–۱۲۰۰) و (۴۴۰–۵۸۰cm) دیده می شوند. ($w_s(k)$ در رابطه بالا معرف سرعت گروه است که به ازای مقادیری از $\omega_s(k)$ مفر شده و سبب تکینگی در چگالی مدها می گردد که به تکینگی های وان هاف مشهورند [۲۱] و درچگالی حالت های فاز مان می می می می فرند. (تا BaHfO) می مغربی می باشند. همچنین دو گاف فرکانسی در بازه ی از معاد می از معاد می می باشند. همچنین دو گاف فرکانسی در بازه می می باشند. همچنین دو گاف فرکانسی در بازه می می خورند. (۲۰۰–۲۰۰

شکل ۹ منحنی پاشندگی بلور BaHfO_۳ را در فاز مکعبی در تقریب GGA نشان می دهد که در بازه(^۱-۴۰۰cm) تعداد و پیچ خوردگی نوارها نسبت به فرکانس های بالاتر خیلی بیشتر بوده و گاف فرکانسی کوچک این بازه نیز با منحنی چگالی حالت ها (در شکل ۸) مطابقت دارد.



شکل۹: شاخه های اپتیکی و اکوستیکی رابطه پاشندگی برای فاز مکعبی بلور BaHfO در تقریب GGA .

مشاهده می شود که در لبه ی نقاط با تقارن بالای G، X، M و R، منحنی پاشندگی مد های آکوستیکی عملا تخت می شود. با افزایش فرکانس های مجاز ارتعاشی در بلور، نقش مدهای اپتیکی پر رنگتر شده، بطوری که مدهای با فرکانس های بالا می توانند با تابش الکترومغناطیس برهمکنش کرده و نقش اصلی را در بیشتر خواص اپتیکی بلورهای یونی داشته باشند. همچنین بیشترین تبهگنی های مشاهده شده مربوط به نقاط R,G و M هستند که دلالت برتقارن بالای بلور در نقاط فوق دارد.

۳-۳-۳ تابع دی الکتریک و قطبش پذیری

پا سخ یک سیستم به میدان های الکتریکی خارجی، تابع دی الکتریک ٤ نامیده می شودکه برای محیط های هم سانگرد یک کمیت ا سکالر و برای محیط های غیر همسانگرد با توجه به سمتگیرهای مختلف میدان الکتریکی، یک تانسور مرتبه دو است. بعضی از مولفه های این تانسور، یعنی (۵), ٤_{zx}(۵), ٤_{zy}(۵), ٤_{yy}(۵), ٤_{yy}(۵), ٤_{yy}(۵), ٤_{zy}(۵), ۲_{zz}(۵), ۲_{zz} محیط می توانند صفر شوند. تقارن مکعبی ساختار مورد بررسی سبب شده تا آرایه های غیر قطری ماتریس دی الکتریک صفر و عناصر قطری آنها نیز با یکدیگر مساوی

 $\epsilon_{\infty} = \cdot \epsilon_{\infty} + \epsilon_$

باشند که حاکی از تقارن کامل بلور ۳BaHfO در فاز مکعبی دارد. بر همین اساس، قطبش پذیری ترکیب فوق نیز به صورت یک ماتریس قطری ظاهر می شود:

$$P(A^{\text{T}} \text{ units}) = \cdot P(A^{\text{T}} \text{ un$$

برای یک ملکول، قطبش پذیری توانایی برای قطبی شدن است که جز خواص ماده نیز محسوب می گردد در حالی که برای یک ترکیب، به عنوان پاسخ دینامیکی آن به میدان های خارجی تعریف می شود.

۳–۳–۴– بار موثر

یکی از پارامترهای مهم در مطالعه خواص پیزو الکتریک بار موثر است که نخستین بار توسط بورن به عنوان "تعریف دینامیکی بار اتمی" ارائه گردید. بار موثر بورن همراه با ثابت دی الکتریک الکترونی حاکم بر برهمکنش بلند- برد کولنی مسئول جدایی فونون های اپتیکی (LO) و عرضی (TO) است. همچنین بار موثر، خصلت کووالانسی بودن پیوند را نیز آشکار می کند[۲۱]که به صورت زیر محاسبه می گردد :

$$Z_s^{\alpha\beta} = \Omega \frac{\partial p_\alpha}{\partial u_s^\beta}$$

در جدول ۴ بار موثر اتم های شرکت کننده در فاز مکعبی بلور BaHfOr برحسب dF/dE و dP/du ارائه شده است.

بار موثر Z ^β _{sα} بر حسب(dF/dE)	$(rac{dp}{du})$ بار موثر Z^{seta}_{lpha} بر حسب (
۲/۷۳۷ ۰ ۰	·/TYTY · ·
$Z^*(Ba) = \cdot \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma$	$Z^*(Ba) = \cdot \cdot / \Upsilon \vee \Upsilon \vee \cdot$
· · · ٢/٧٣٧	· · ·/٢٧٣٧
۵/۶۶۹ ۰ ۰	•/288 • •
$Z^*(Hf) = \cdot \Delta/999$ ·	$Z^*(Hf) = \cdot \cdot /\Delta 99$
· · ۵/۶۶۹	· · ·/۵۶۶
-4/180 · ·	/۴١۶
$Z^*(O_x) = \cdot - 1/97 \cdot \cdot$	$Z^*(O_x) = \cdot - \cdot / 197 \cdot$
· · -1/97·	· · ·/۱۹۲
-1/95	/195 · ·
$Z^*(O_z) = \cdot -1/97 \cdot \cdot$	$Z^*(O_z) = \cdot - \cdot / 197 \cdot$
· · · - ۴/١۶۵	· · -·/۴١۶
-1/97	/195
$Z^*(O_y) = \cdot - \epsilon/1$ \cdot	$Z^*(O_y) = \cdot - \cdot / f_1 \varepsilon$
· · - 1/97·	· · -·/١٩٢

جدول ۴ : بار موثر اتم های شرکت کننده در فاز مکعبی بلور باریم هافنیمات با تقریب GGA .

که در آن اتم _xO دارای مختصات (۵/۰٫۰/۵٫۰)، _VO دارای مختصات (۵/۰٫۰/۵) و _zO دارای مختصات (۰/۵٫۰/۵٫۰) می باشد. از آن جایی که فاصله اتم های اکسیژن- سرب و تیتانیم، در سه راستای x، y و z فاز مکعبی باریم هافنیمات، مساوی اند، مقدار بار موثر آلیاژ نیز در هر سه راستا برابراند. همانطور که در جدول مشاهده می شود بار موثر اتم های Hf ،Ba و O در مقایسه با مقدار اسمی یونی شان (۲٬۴٬۲-) تغییر کرده، که دلالت بر خصلت یونی-کووالانسی ترکیب فوق ناشی از هیبریداسیون اوربیتال های مرا - ۲۶-۲۰ و Da - ۲۶-۲۰) تغییر کرده، که دلالت بر خصلت یونی-کووالانسی ترکیب فوق ناشی از هیبریداسیون اوربیتال های ارتعاشی ترکیب می باشند. هر چه بار موثر هسته کاتیون*Z بیشتر باشد قدرت قطبی کنندگی آن نیز بیشتر بوده و بهتر می تواند الکترون های خارجی آنیون های مجاور را به سمت خود جذب کند و در نتیجه خصلت کووالانسی پیوند افزایش می یابد، و از طرف دیگر هر چه خصلت کووالانسی بیشتر باشد نقطه جوش کمتر و حلالیت در حلال های قطبی نیز کمتر می گردد[۲].

(IIR) حاسبه شدت امواج فروسرخ-

امواج فروسرخ در ناحیه طول موجی ۱ میلی متر تا ۷۵۰ نانو میلی متر قرار دارند که طیف بینی این امواج ، میزان جذب و انتقال فونونها را در محدودهی انرژی فروسرخ نشان می دهد که بر اساس شدت و فرکانس می باشد. شدت این امواج را می توان مستقیما از مربع بار موثر و الگوی جابجایی فونون محاسبه نمود که از رابطه زیر بدست می آید:

$$I_{IR}(v) = \sum_{\alpha} \left[\sum_{s\beta} Z_s^{*\alpha\beta} U_s^{\beta}(v)\right]^{\mathsf{T}}$$

درجدول ۵ شدت های فروسرخ برحسب فرکانس(۵) مد های ارتعاشی باریم هافنیمات در تقریب GGA داده شده است.

شماره	ω (cm ⁻))	I _{IR} ((D/A) ^Y /amu)
مد		
١	•/•••	•/•••
٢	•/•••	•/••••
٣	•/•••	•/•••
۴	۲۳/۳۵	F/VT 1
۵	۲۳/۳۵	F/VT 1
۶	ΔΥ/١٢	•/• \Y
٧	١٣٩/•٧	۳۳/۵۶۰
٨	١٣٩/•٧	۳۳/۵۶۰
٩	266/92	•/•••
١.	266/92	•/••••
11	266/92	•/•••
١٢	۳۹۱/۸۶	٣/٣٩ ١
١٣	418/89	٢/۴٨٩
14	<i>۴۱۶/۳۹</i>	۲/۴۸۹
۱۵	۵۳۷/۴۲	٣٩/٣۶٣

جدول ۵: شدت های فروسرخ برای فرکانس های مدهای ارتعاشی بلور باریم هافنیمات در فاز مکعبی.

همانطور که در جدول دیده می شود ماکزیمم شدت ها مربوط به فرکانس(^۳۹۱/۸۶cm) و مینیمم شدت ها مربوط به فرکانس(^۳-۰۰) می باشند.

۳–۵– آنتالپی

آنتالپی مقدار گرمای سیستم در فشار ثابت است که برای حالت ایده آل به صورت زیر تعریف می شود:

H=E+PV

که H نمایشگر آنتالپی سیستم، p میزان فشار در مرز و V نماینگر حجم سیستم می باشد. آنتالپی در حقیقت یک تابع حالت است که مقدارش فقط به حالت های آغازی و پایانی فرآیند بستگی دارد [۲۱]. در جدول ۶ آنتالپی بلور باریم هافنیمات در فشارهای مختلف آمده است.

فشار (Kbar)	(a.u. [°]) حج م	انرژی (Ry)	أنتاليى(Ry)
•	47 I/+ 4V	-۲۴۶/۱۷۵۸	-248/1124
١	۴۰۸/۷۸۸	-748/111	-۲۴۵/۸۹۳
۲۰۰	۳۸٩/۰۰۹	-748/18•	-240/819
۳۰۰	388/1918	-748/144	-240/202
4	۳۷۹/۷۱۱	-748/174	-740/•91
۵۰۰	WY 1/ATA	-८६४/•८४	-744/828
۶	۳۶۴/۵۹ I	-748/•74	-744/282
٧	307/977	-748/•44	-744/84•
٨٠٠	TA1/VAT	-748/•17	-744/•99
٩	846/ •• 1	-tfd/9VL	$-\Upsilon F T / \Lambda F I$

جدول ۶. محاسبه آنتالبی در فشار های مختلف برای فاز مکعبی باریم هافنیمات در تقریب GGA .



شکل۱۱. نمودار آنتالپی بر حسب فشار برای باریم هافنیمات در فاز مکعبی.

همانطور که درجدول ۶ و شکل ۱۱ دیده می شود روند تغییرات خطی و افزایشی است. از نمودار آنتالپی بر حسب فشار چنین استنباط می شود که وقتیBaHfOr تحت فشار قرار می گیرد فاصله بین ملکول های سیستم کاهش یافته ولی به دلیل افزایش مقدار انرژی در سیستم، آنتالپی نیز افزایش می یابد که در نتیجه کاهش درآنتروپی، افزایش در انرژی آزاد گیبس و افزایش پایداری سیستم را به دنبال دارد.

۴- نتیجه گیری

خواص ساختاری ، الکترونی و ارتعاشی ترکیب ،BaHfO در فاز مکعبی و با استفاده از بسته نرم افزاری کوانتم اسپرسو مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از ساختار نواری نشان می دهد که ترکیب فوق یک گاف نواری مستقیم در نقطه G دارد که سهم اوربیتالهای O-7 در فرایند انتقال یک الکترون با انرژی E از نوار ظرفیت پر به نوار رسانش خالی از بقیه بیشتر بوده، در حالی که اوربیتال های P-O در فرایند انتقال یک الکترون با انرژی E از نوار ظرفیت پر به نوار رسانش خالی از بقیه بیشتر بوده، در حالی که اوربیتال های P-O در فرایند انتقال یک الکترون با انرژی E از نوار ظرفیت پر به نوار رسانش خالی از بقیه بیشتر بوده، در عمدتاً یونی و بین اتمهای Hf و O یونی-کووالانسی است که ناشی از اختلاف الکترونگاتیوی آنها است. نتایج حاصل از بار موثر نیز خصلت یونی و بین اتمهای Hf و O یونی-کووالانسی است که ناشی از اختلاف الکترونگاتیوی آنها است. نتایج حاصل از بار موثر نیز خصلت یونی و ۲ تای دیگر اپتیکی هستند) که جز گروه نقطه نگاری _IO با گروه فضایی (m۳m) هستند. در نمودار چگالی حالت های فونونی دو پیک یکی در فرکانس های پایین(¹-۳۳۳) و دیگری در فرکانس های بالا حدود (¹-۴۱۰۳)وجود دارند که معرف مد های اکوستیکی و ایتیکی اند. منحنی پاشندگی بلور ۲۰۹۴ماه در فاز مکعبی (با روش GGA) نشان می دهد که پهن شدگی و پیچ خوردگی نوار ها در بازه(¹-۴۰۰۴) نسبت به فرکانس های بالاتر خیلی بیشتر است. همچنین تقارن مکعبی ترکیب ۲۰٫۲۳۹۲ هیب شده است تا تانسور دی الکتریک(۲۰٫۴۸) و قطبش پذیری (۲۲/۳۹۲) هر دو قطری باشند.

۵- مراجع

- [1] J.G. Bednorz, K.A. Muller, *Phys. Rev. Lett.* **52** (1984) 2289.
- [2] C.B. Samantaray, H. Sim, H. Hwang, Microelectron. J. 36 (2005) 725.
- [3] C.B. Samantaray, H. Sim, H. Hwang, *Physica B* 351 (2004) 158.
- [4] P.Baettig, C.F.Schelle, R.Lesar, U.V.Waghmare and N.A.Spaldin, Chem. Mater. 17(2005) 1376.
- [5] H.Wang, B.Wang, Q.Li, Z.Zhu, R.Wang, C.H.Woo, Phys. Rev. B 75(2007) 245209.
- [6] C.SKoonce, M.L.Cohen, J.F.Schooley, W.R.Hosler, E.R.Pfeiffer, Phys. Rev. 163 (1967) 380.
- [7] V.E. Henrich, Rep. Prog. Phys. 48 (1985) 1481.
- [8] V.E.Henrich, P.A.Cox, The Surface Science of Metals Oxides, Cambridge Univ. Press, New York, (1994).
- [9] O. Auciello, J.F. Scott, R. Ramesh, Phys. Today 51 (1998) 22.
- [10] E. Mete, R. Shaltaf, S. Ellialtioglu, Phys. Rev. B 68 (2003) 035119.
- [11] M.P.Jorba, G.Tilloca and R.Collongues, *Int.Symp.Magnetohydrodyn. Elec. Power Gen.* 3 (1964) 1185.
- [12] E.V. Van Loef, W. M. Higgins, J. Glodo, C. Brecher, A. Lempicki, V.S. Venkataramani,
- W.W.Moses, S.E. Derenzo, and K.S., Shah, IEEE T. Nucl. Sci. 54(3),741, (2007).
- [13] <u>http://physics.nist.gov/cgi-bin/Xcom/xcom2</u>.
- [14] P. Hohenberg and W. Kohn, Phys. Rev. B 136 (1964) 864
- [15] W. Kohn and L. J. Sham, phys, Rev. A 137 (1965) 1697.
- [16] http://www.quantum-espresso.org/.
- [17] D. Ceperley and B. Alder. Phys. Rev. Lett. 45 (1980) 566.
- [18] J. P. Perdew, K. Burke and Y. Wang, Phys. Rev. B 54 (1996) 16533.
- [19] A. Bouhemadou, F. Djabi and R. Khenata, Physics Letters A 372 (2008) 4527-4531.

[20] . مرادى،اعظم، شفيعى گل حيدر على؛ خواص بلورهاى گاليم نيتريد، پايانامه كارشناسى ارشد دانشگاه سيستان و بلوچستان،

زمستان ۱۳۹۲.

- [21] C. Kittel," Introduction to Solid State Physics", John Wily &Sons, (2005).
- [22] N. Ashcraft, "solid state physics", (1976).
- [23] P. Atkins, "Physical chemistry", 9 Edition, (2006).